

specificazioni	
Numero di parte	GP1M006A070FH
fabbricante	Global Power Technologies Group
Descrizione	MOSFET N-CH 700V 5A TO220F
Categoria	Prodotti a semiconduttore discreti > Transistor-FET,
Stato parte	2651 pcs Stock
Vgs (th) (max) a Id	4V @ 250μA
Tecnologia	MOSFET (Metal Oxide)
Contenitore dispositivo fornitore	TO-220F
Serie	-
Rds On (max) a Id, Vgs	1.65 Ohm @ 2.5A, 10V
Dissipazione di potenza (max)	39W (Tc)
imballaggio	Tube
Contenitore / involucro	TO-220-3 Full Pack
temperatura di esercizio	-55°C ~ 150°C (TJ)
Tipo montaggio	Through Hole
Capacità di ingresso (Ciss) (Max) @ Vds	1500pF @ 25V
Carica Gate (Qg) (Max) @ Vgs	23nC @ 10V
Tipo FET	N-Channel
Caratteristica FET	-
Tensione drain-source (Vdss)	700V
Corrente - Drain continuo (Id) @ 25 ° C	5A (Tc)

 GP1M008A025CG Global Power Technologies Group MOSFET N-CH 250V 8A DPAK	 GP1M006A065F Global Power Technologies Group MOSFET N-CH 650V 5.5A TO220F	 GP1M007A090H Global Power Technologies Group MOSFET N-CH 900V 7A TO220	 GP1M006A065CH Global Power Technologies Group MOSFET N-CH 650V 5.5A DPAK
 GP1M007A065CG Global Power Technologies Group MOSFET N-CH 650V 6.5A DPAK	 GP1M006A065FH Global Power Technologies Group MOSFET N-CH 650V 5.5A TO220F	 GP1M007A090FH Global Power Technologies Group MOSFET N-CH 900V 7A TO220F	 GP1M008A025FG Global Power Technologies Group MOSFET N-CH 250V 8A TO220F

Di Più

Contact us: **Info@YIC-Electronics.com**

AGGIUNGI: Unit A5-B5 No.509, 5 / F Sing Win Factory Building, 15-17 Shing yip St, Kwun Tong, Kowloon, Hong Kong.

Copyright © 2023 YIC-Electronics.com - YIC International Co., Limited